

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】令和6年3月18日(2024.3.18)

【公開番号】特開2023-39081(P2023-39081A)

【公開日】令和5年3月20日(2023.3.20)

【年通号数】公開公報(特許)2023-052

【出願番号】特願2021-146056(P2021-146056)

【国際特許分類】

C 23 C 16/42(2006.01)

10

H 01 L 21/28(2006.01)

H 01 L 21/285(2006.01)

【F I】

C 23 C 16/42

H 01 L 21/28 301S

H 01 L 21/285 C

H 01 L 21/28 301R

【手続補正書】

【提出日】令和6年3月8日(2024.3.8)

20

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項7】

前記成膜阻害剤を形成する工程は、前記チタンシリサイド膜を成膜する工程に先立って、または、前記チタンシリサイド膜を成膜する工程の際に行われる、請求項5または請求項6に記載の成膜方法。

【手続補正2】

30

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項9】

前記チタンシリサイド膜を成膜する工程は、前記還元ガスとして、前記Si含有ガスの他に、H₂ガス、重水素含有ガス、NH₃ガスの少なくとも1種を供給する、請求項1から請求項8のいずれか一項に記載の成膜方法。

【手続補正3】

40

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項15

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項15】

前記成膜阻害剤を形成する工程は、前記チタンシリサイド膜を成膜する工程に先立って、または、前記チタンシリサイド膜を成膜する工程の際に行われる、請求項13または請求項14に記載の半導体装置の製造方法。

【手続補正4】

50

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項18

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1 8】

前記チタンシリサイド膜を成膜する工程は、前記還元ガスとして、前記Si含有ガスの他に、 H_2 ガス、重水素含有ガス、 NH_3 ガスの少なくとも1種を供給する、請求項11から請求項17のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。

10

20

30

40

50